关键指标

频率：20～40GHz
增益：24dB@28GHz
1dB 压缩点输出功率：22dBm
电压/静态电流：+5V/140mA,Vg：-0.6V
芯片尺寸：2mm×0.9mm

产品简介

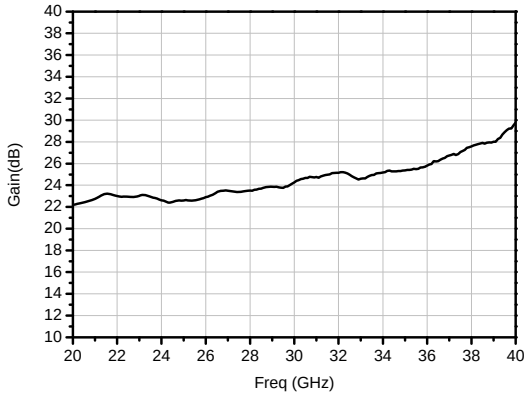
HG128FC 驱动放大器芯片，采用 GaAs pHEMT 工艺制作，双电源供电，输入输出端均集成有隔直电容。

电性能（T_A=25℃，Vdd=+5V, Vg=-0.6V）

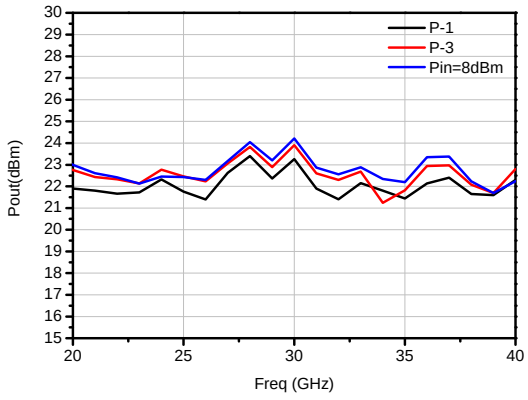
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)		20～40	
增益(dB)	–	25	–
输入驻波	–	1.6	–
1dB 压缩点输出功率（dBm）	–	22	–
输出功率（dBm）	–	22.5	
静态电流（mA）	–	140	–

典型测试曲线

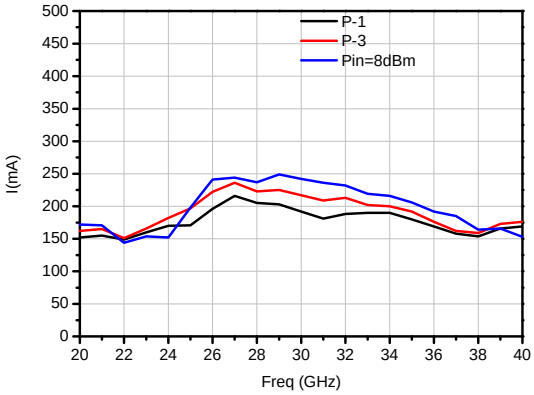
增益



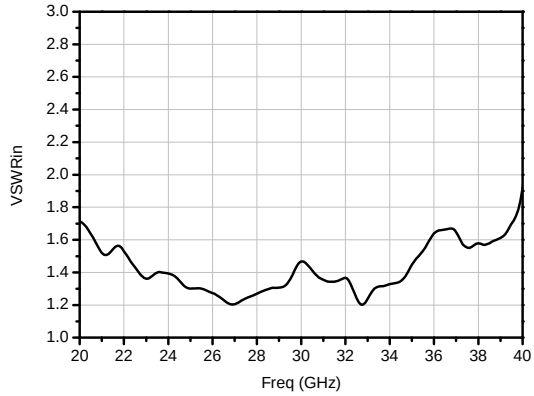
输出功率



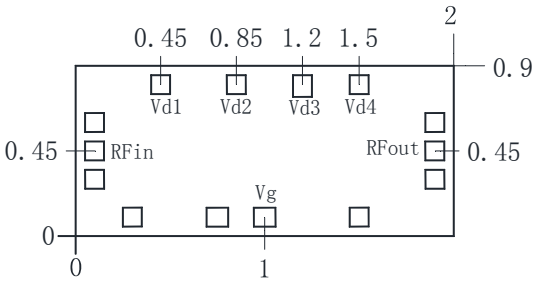
工作电流



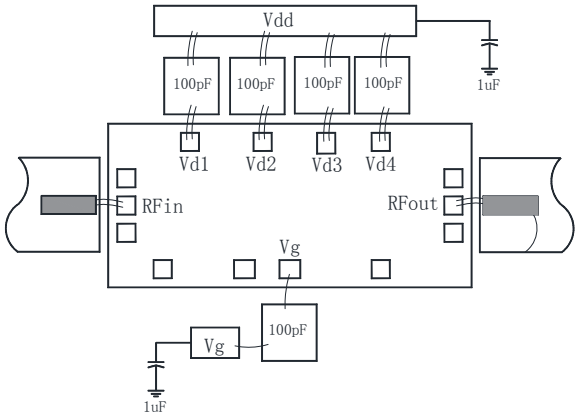
输入驻波



外形和端口尺寸（mm）



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55℃～125℃
存储温度	-65℃～150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250～400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。